

一、简介

浪拓电子 BS0060SS 系列半导体放电管(瞬态浪涌抑制器 TSS),主要应用于信号口过压保护, XDSL 二次侧保护, 节电容小于 15pF。

二、型号命名说明

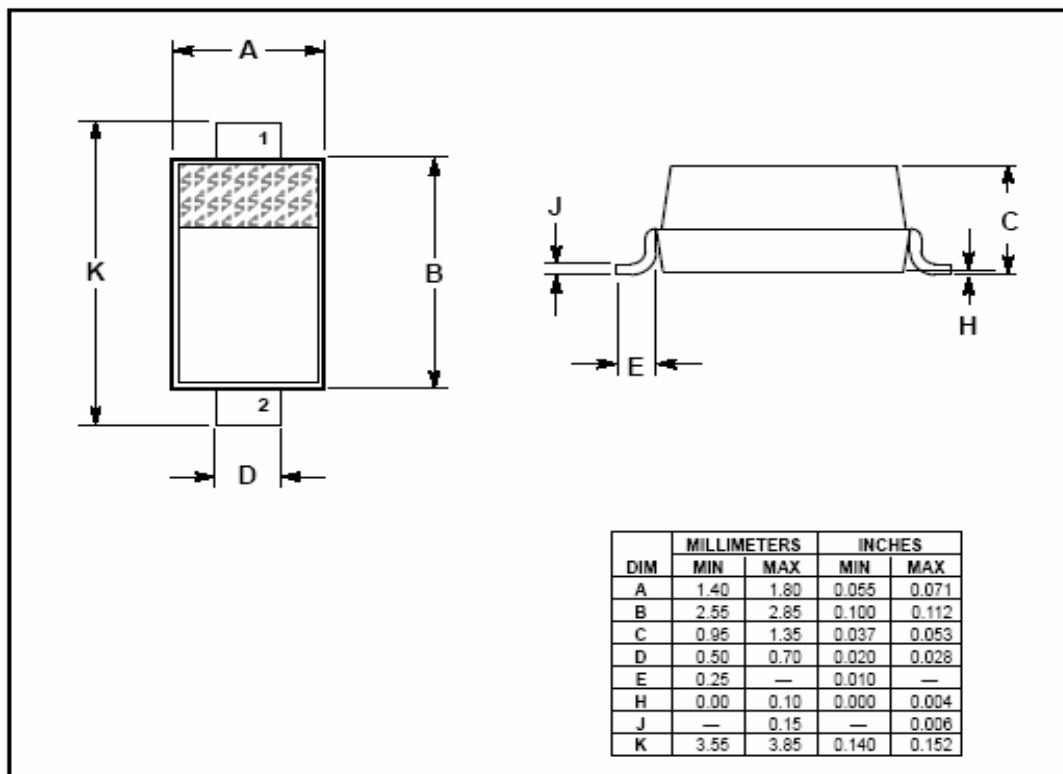
BS 0060 S S
 (1) (2) (3) (4)

- (1)浪拓电子半导体系列;
- (2)产品系列: 0040、0060、等;
- (3)封装形式: SOD-123;
- (4)浪涌承受能力: 15A(10/1000 μ S)。

三、特性

- 适合高密度表面贴装的防静电浪涌吸收器。
- 无极性、双向浪涌保护、吸收特性良好;
- 节电容小于 15Pf, 可满足 VDSL 等高速率传输线路的需要
- 纳秒级的反应速度, 使设备对雷电突波、瞬间过电压防护更加安全、可靠;
- 高绝缘阻抗特性
- 重复性优良, 寿命长, 不会疲劳失效。
- 符合 IEC61000-4-2 规格。

四、外型尺寸



BS0060SS
五、电气参数 (@T=25°C,RH=45%-75%)

	断态电压		转折电压		通态压降		维持电流	极间电容
	VDRM	IDRM	VS	IS	VT	IT	IH	CO
	V	μA	V	mA	V	A	mA	pF
		MAX	TYPE	MAX	MAX		MIN	MAX
BS0060SS	6	5	12	800	4	1	50	15

- 以上参数均在室温 25°C时测得;
- 常规型号极间电容在 1MHz@ DC2V;
- 该产品系列可承受 50A (8/20uS) ,15A(10/1000uS)。

六、可靠性试验项目

试验内容	参考标准	试验条件	试验方法	实验结果
高温反偏试验	MIL-STD-750B METHOD-1026	TA=150°C BiasV=80%VDRM T=96Hours	在规定温度烤箱中,放电管两极加以规定的偏压,持续指定的时间。	初始检测、最终检测满足各项技术要求。
耐焊接热试验	MIL-STD-750B METHOD-2031	TA=260+5°C/-0°C T=10Sec	直接放入锡炉中	初始检测、最终检测满足各项技术要求。
可焊性试验	MIL-STD-202E METHOD-208	TA=230°C T=5Sec	直接放入锡炉中	初始检测、最终检测满足各项技术要求。

七、标识

举例	封装	型号	标识
	SOD-123	B0060SS	B006S 0526

标识说明(Notes): B 006 S 0526

(1) (2) (3) (4)

(1)浪拓半导体系列: langtuo Semiconductor Surge Protector;

(2)产品系列: 0040、0060、等;

(3)封装(Package): SOD-123;

(4)产品的生产日期(Date) 如: 0526 表示 2005 年第 26 周。

八、包装

包装	卷筒直径 (英寸)	数量
编带 1	7	3K
编带 2	13	10K